



ID Oferty: #JOB21/2017

Opis stanowiska

Stanowisko: adiunkt, 75% etatu

Krótką informacją o stanowisku:

Specjalista w technologii ALD otrzymywania cienkich warstw oraz w tematyce fotowoltaiki

Szczegółowy opis stanowiska pracy:

Kandydat będzie odpowiedzialny za prace w tematyce fotowoltaiki w zespole naukowym ON-4.2. Będzie wzrastał aktywne warstwy w komórkach fotowoltaicznych metodą ALD (Osadzania Warstw Atomowych). Otrzymane struktury fotowoltaiczne będą charakteryzowane z wykorzystaniem szeregu dostępnych metod badawczych. Dlatego kandydat powinien posiadać udokumentowane doświadczenie w tych (metody elektryczne i optyczne) metodach badania złącz półprzewodnikowych.

Profil kandydata na ogłaszane stanowisko:

1. Doktorat z fizyki
2. Co najmniej pięć lat doświadczenia w technologii ALD i w fotowoltaice dokumentowana publikacjami i prezentacjami konferencyjnymi
3. Doświadczenie w charakteryzacji złącz wybranymi metodami badawczymi
4. Zdolności interpersonalne
5. Umiejętność pracy w zespole naukowym
6. Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego

Dyscyplina naukowa: Fizyka

Specjalność: Fizyka ciała stałego

Doświadczenie: Średniozaawansowany lub 4-10 lat (Post-Doc)

Profil naukowy wg EURAXESS ([szczegóły](#)): Recognised Researcher (R2)

Tryb zatrudnienia: Czas nieokreślony

Wymiar etatu: Częściowy etat

Wynagrodzenie: W zależności od kwalifikacji.
Od 3000 do 6000) PLN miesięcznie (brutto).

Kontakt

Dodatkowe informacje o stanowisku udziela prof. dr hab. Marek Godlewski (e-mail: godlew@ifpan.edu.pl).

ResearcherID: S-5288-2016

<http://www.ifpan.edu.pl>

Składanie dokumentów

Termin składania: 15 września 2017 r. Możliwe jest rozpatrywanie zgłoszeń po terminie.

Wymagane dokumenty:

- Curriculum Vitae
- Lista publikacji
- List motywacyjny

Wszystkie materiały należy przesłać w formie elektronicznej na adres:

jobs@ifpan.edu.pl podając w temacie ID Oferty.